This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

		* \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \						
	i de la companya di seriesa di se				₹ } 			

	10 11							
		l was		4	artina.			
2)								
		ili Ali Pariginjaka						
		A						
		A STATE OF THE STATE OF	e de la companya de l					
		ing we Take						
					N.S. Barrier	to the property of the second		
			er de					V
. :			* . 4					Š
		Nag e di						
							11	
		*	* ************************************					
	er *	•		• •				
								.0
				•	1 4	na Romania		
	1-		÷					**
		4						
			*					
		,						
i.					•			
*		Sala gradient de la company			***************************************	$\varphi_{i} = \varphi_{i} \circ \varphi_{i} \circ \varphi_{i}$		
s 15 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5	·**:				•			
			. *		Tarana and the			
		$\mathcal{L}_{\mathcal{L}} = \{\mathcal{L}_{\mathcal{L}} \mid \mathcal{L}_{\mathcal{L}} = \mathcal{L}_{\mathcal{L}} \}$			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		, 1	
·					* *			
		•						
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		*		at the second of		
						1. 11		
			**					
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1	. '

(19)日本国特許庁(JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-84881

(43)公開日 平成6年(1994)3月25日

(51)Int.Cl.⁵

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

H 0 1 L 21/306

J 9278-4M

審査請求 未請求 請求項の数5(全 8 頁)

(21)出願番号

特願平4-255945

(22)出願日

平成 4年(1992) 8月31日

(71)出願人 000190149

信越半導体株式会社

東京都千代田区丸の内1丁目4番2号

(72)発明者 加藤 忠弘

福島県西白河郡西郷村大字小田倉字大平 150番地 信越半導体株式会社半導体白河

研究所内

(72)発明者 工藤 秀雄

福島県西白河郡西郷村大字小田倉字大平

150番地 信越半導体株式会社半導体白河

研究所内

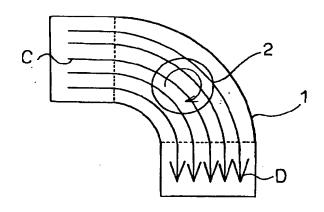
(74)代理人 弁理士 舘野 公一

(54)【発明の名称】 高精度エッチング方法と装置

(57)【要約】

【目的】 ウェーハ面の各部位とエッチング用薬液間の 相対平均流速の均一化を図ると共に、ウェーハのエッジ 部におけるエッチング処理時の形状変化を低減し、高精 度のエッチドウェーハを形成する方法とそれを実施する ための簡便構造の装置を提供する。

【構成】 薬液を流通する円弧状の流路1内でウェーハ 2を自転させるか、または円環状の薬液槽内でウェーハ 2を公転および自転させてウェーハ2面の各部位と薬液 間の相対平均流速の均一を図ると共に、ウェーハ2の外 縁近傍にテンプレートを配置し、エッジ部における流れ の整流化を図るように構成される。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 エッチング用の薬液に半導体単結晶ウェーハを回転させながら浸漬させ、前記ウェーハの表面をエッチング処理するエッチング方法であって、前記薬液を円弧状の流路に沿って流通させ、前記流路を流れる薬液が曲がる方向と同一回転方向に前記ウェーハを自転させて、前記ウェーハ面の各部位に対する薬液の相対平均流速を均一にさせることを特徴とする高精度エッチング方法。

【請求項2】 エッチング用の薬液に半導体単結晶ウェ 10 ーハを浸漬させると共に、前記ウェーハ面の各部位に対する薬液の相対平均流速を均一にして、前記ウェーハの表面をエッチング処理する高精度エッチング装置であって、前記薬液を流通させる円弧状の流路と、前記ウェーハを吸着保持する吸着手段と、前記ウェーハを自転させる回転手段を設けることを特徴とする高精度エッチング装置。

【請求項3】 エッチング用の薬液に半導体単結晶ウェーハを回転させながら浸漬させて、前記ウェーハの表面をエッチング処理するエッチング方法であって、前記ウェーハを円環状の薬液槽に沿って公転させるとともに、前記ウェーハの公転方向と反対回転方向に自転させて、ウェーハ面の各部位に対する薬液の相対平均流速を均一にさせることを特徴とする高精度エッチング方法。

【請求項4】 エッチング用の薬液に半導体単結晶ウェーハを浸漬させると共に、前記ウェーハ面の各部位に対する薬液の相対平均流速を均一にして、前記ウェーハの表面をエッチング処理する高精度エッチング装置であって、前記薬液を蓄溜する円環状の薬液槽と、前記ウェーハを吸着保持する吸着手段と、前記ウェーハを前記薬液 30 槽の円周に沿って公転させる公転手段と、前記ウェーハを自転させる回転手段を設けることを特徴とする高精度エッチング装置。

【請求項5】 前記吸着手段のウェーハの外縁近傍には、前記ウェーハの外縁と適宜間隙を隔て、かつウェーハのエッチング処理される表面とほぼ同一面上に配設されるテンプレートを設けることを特徴とする請求項2又は4に記載の高精度エッチング装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、シリコンのような半導体単結晶の棒をスライスした後、その主表面を研磨することにより得られる円盤状の半導体単結晶ウェーハ(以下単にウェーハとする)の表面を均一にエッチング処理するに好適な高精度エッチング方法と装置に関する。

[0002]

【従来の技術】ウェーハにおけるケミカルエッチングは、①スライスや研磨等の機械加工によって生じたウェーハ表面の歪層の除去、②結晶欠陥の観察、③選択エッチングの利用による微細加工等の目的に用いられてい

る。本発明は上記①を目的とするもので、従来一般的に 採用されているウェーハのエッチング方法は、バブリン グ等による薬液の液流中で、ウェーハを回転させながら エッチングする方式のものである。この場合、薬液の液 流速の制御が困難であり、そのためウェーハ面内のエッ チ代バラツキを小さくすることができず、高精度の平坦 度をもったケミカルエッチドウェーハを得ることが困難 であった。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】ウェーハは、その表面 にエッチング用の薬液を移動させながら接触せしめるこ とによってエッチング処理されるが、この際ウェーハ と、それに接触する薬液との間の各部位における相対平 均流速を、極力均一に保持しないとウェーハ各部位のエ ッチング代のバラツキ、即ち平坦度を小さくすることが できない。そのため、従来のエッチング方法では高精度 の平坦度を有するケミカルエッチドウェーハを作ること が困難であった。また、エッチング処理中に発生する反 応ガスにより、ウェーハの表面にスジ状或いはランダム な凹凸が形成される。そのため、ウェーハを自転させる ことにより平滑化する事が必要となる。また、薬液はウ ェーハの外縁のエッジ部に当ってから、ウェーハの主表 面に対しほぼ平行してその中心側に向かって流れるが、 前記エッジ部で両者の相対平均流速が局所的に変化す る。そのため、該エッジ部のエッチング処理が特に不完 全になり易い。図11および図12はその状態を示すも のである。すなわち、図11に示すようにウェーハ2 は、自転或いは自転していない状態で矢印の方向から薬 液が流入すると、前記したように前記エッジ部で流速が 変化し、図12に示すようにエッジ部に局部的な形状異 常47を生ずる。この形状異常47の発生によりその周 辺も影響を受け、均一のエッチング処理が行われず、平 坦な形状を得ることができない。なお、図12は図の縦 方向がウェーハ2の厚さ方向を示し、横方向が半径方向 を示すものでそれぞれ拡大表示されている。

[0004] 本発明は、以上の問題点を解決するもので、薬液とウェーハ間の相対平均流速を極力均一にしてウェーハ面内のエッチング代のバラツキと反応ガスによる凹凸を低減して高精度の平坦度を有するウェーハを形成すると共に、比較的構造が簡単で、かつ容易に実施し得る高精度エッチング方法と装置を提供することを目的とする。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明の請求項1 に記載の高精度エッチング方法は、エッチング用の薬液に半導体単結晶ウェーハを回転させながら浸漬させ、前記ウェーハの表面をエッチング処理するエッチング方法であって、前記薬液を円弧状の流路に沿って流通させ、前記流路を流れる薬液が曲がる方向と同一回転方向に前記ウェラルを自転させて、前記ウェーハ面の各部位に対する薬

液の相対平均流速を均一にさせることを特徴とする。 【○○○6】本発明の請求項2に記載の高精度エッチン グ装置は、エッチング用の薬液に半導体単結晶ウェーハ を浸漬させると共に、前記ウェーハ面の各部位に対する 薬液の相対平均流速を均一にして、前記ウェーハの表面 をエッチング処理する髙精度エッチング装置であって、 前記葉液を流通させる円弧状の流路と、前記ウェーハを 吸着保持する吸着手段と、前記ウェーハを自転させる回 転手段を設けることを特徴とする。

【0007】本発明の請求項3に記載の高精度エッチン グ方法は、エッチング用の薬液に半導体単結晶ウェーハ を回転させながら浸漬させて、前記ウェーハの表面をエ ッチング処理するエッチング方法であって、前記ウェー ハを円環状の薬液槽に沿って公転させるとともに、前記 ウェーハの公転方向と反対回転方向に自転させて、ウェ ーハ面の各部位に対する薬液の相対平均流速を均一にさ せることを特徴とする。

【0008】本発明の請求項4に記載の髙精度エッチン グ装置は、エッチング用の薬液に半導体単結晶ウェーハ を浸漬させると共に、前記ウェーハ面の各部位に対する 薬液の相対平均流速を均一にして、前記ウェーハの表面 をエッチング処理する髙精度エッチング装置であって、 前記葉液を蓄溜する円環状の薬液槽と、前記ウェーハを 吸着保持する吸着手段と、前記ウェーハを前記薬液槽の 円周に沿って公転させる公転手段と、前記ウェーハを自 転させる回転手段を設けることを特徴とする。

【0009】本発明の請求項5に記載の髙精度エッチン グ装置は、前記吸着手段のウェーハの外縁近傍には、前 記ウェーハの外縁と適宜間隙を隔て、かつウェーハのエ ッチング処理される表面とほぼ同一面上に配設されるテ ンプレートを設けることを特徴とする。

[0010]

【作用】請求項1の髙精度エッチング方法においては、 エッチング用の薬液を円弧状の流路に沿って流通させ、 流路を流れる薬液が曲がる方向と同一回転方向にウェー ハを自転させてエッチングを行う。この方法では、薬液 の流速とウェーハ回転の合成が実際の相対流速となる。 この相対流速を時間平均で均一にするために、研磨の原 理を利用している。研磨では、ウェーハ(トップリン グ) が自転しかつ下定盤が回転しているが、トップリン 40 グ回転数と定盤回転数を合わせることにより、ウェーハ 面内の相対速度(ウェーハと研磨クロス)を均一にして いる。そこで、薬液の流れを円弧状にし、かつ、流路を 流れる薬液が曲がる方向と同一回転方向にウェーハを自 転させることによって、研磨と同様な条件を作り出すこ とができる。すなわち、本発明の方法では、エッチング 用の藁液が研磨における研磨クロスに相当し、藁液の流 れあるいはウェーハの公転が研磨における定盤(研磨ク ロス)の回転に相当し、ウェーハの自転が研磨における トップリングによるウェーハの自転に相当する。エッチ

ングの場合、適当なウェーハ回転数とそれに合った適当 な薬液の流速を組合わせることにより、面内均一な相対 平均流速(時間平均相対流速)の発生が可能になる。薬 液の流れが全くの平行流である場合、零を除くいかなる ウェーハ回転数であっても、面内均一な相対平均流速を 得ることはできない(ウェーハ外周が速い)。

【0011】請求項2の高精度エッチング装置において は、円弧状の流路により薬液の円弧状の流れを作ること ができ、ウェーハを吸着保持する吸着手段とウェーハを 自転させる回転手段により、ウェーハを吸着保持しつつ 薬液内で回転させることができるようになり、上記均一 なエッチングが可能になる。

【0012】請求項3の髙精度エッチング方法において は、ウェーハを円環状の薬液槽に沿って公転させるとと もに、ウェーハの公転方向と反対回転方向に自転させ て、ウェーハ面の各部位に対する薬液の相対平均流速を 均一にさせることにより、上記研磨と同様な条件を作り 出している。

【0013】請求項4の髙精度エッチング装置において は、円環状の薬液槽と、ウェーハを吸着保持する吸着手 段と、前記ウェーハを前記薬液槽の円周に沿って公転さ せる公転手段と、前記ウェーハを自転させる回転手段を 備えているために、ウェーハを吸着しつつ、薬液槽にウ ェーハを浸漬した状態でウェーハの公転と自転を行なえ るようになり、上記均一なエッチングが可能になる。

【0014】また、請求項5の髙精度エッチング装置に おいては、吸着手段のウェーハ外縁近傍に、ウェーハの 外縁と適宜間隙を隔て、かつウェーハのエッチング処理 される表面とほぼ同一面上に配設されるテンプレートをよ 設けてあるため、エッチングの際には、テンプレートにつ より薬液の流れが整流されるため、ウェーハの外縁に異 常形状を発生させることがない。

[0015]

【実施例】以下、本発明の一実施例を図面に基づき説明 する。図1乃至図4は本発明のエッチング装置の第1の 実施例を示すものであり、図5乃至図8はその第2の実 施例を示すものである。

【0016】実施例1

図1 に示すように、エッチング用の薬液は円弧状 (図示 では1/4円弧)の流路1内をCから入り、矢印のよう に円弧に沿ってほぼ均一の流速で流通し、Dから流出す る。円盤状のウェーハ2は流路1内に配設される。との ウェーハ2は矢印のように薬液の円弧状の流れ方向と同 じ方向へ自転せしめられる。図2に示すように、ウェー ハ2は後に説明する吸着手段3の吸着盤8に吸着保持さ れ、回転手段4により自転される。また、ウェーハ2の 外縁側には間隙 δ を介してテンプレート5が配置され る。なお、図2において矢印Eはエッチング用薬液の流 れ方向を示し、矢印Fは吸着手段3の真空吸着方向を示 すものである。 50

5

【0017】図3は薬液10の流通する流路1の具体的 形状と、薬液10の供給および排出系路構造を示すもの である。流路1を形成する1/4円弧状の弧状箱体9 は、図4に示すようにウェーハ2および吸着盤8の収納 される枠体部9 a とその開口側に開閉自在に係合する開 閉蓋9bと吸着盤8に連結する回転軸11を支持する支 持部9 c 等から形成される。図3 に示すように、弧状箱 体9の供給側と排出側には分散板12.13を介して分 配器14,15が連結される。供給側の分配器14は流 量計16、開閉弁17およびポンプ18を配置する管路 10 19を介して薬液10を蓄溜する薬液循環槽20に連結 する。なお、管路19には純水を供給する管路21が開 閉弁22を介して連結される。薬液循環槽20は温調器 23により適温に加温される。一方、排出側の分配器1 5には三方開閉弁24を介し戻入管25が連結し、薬液 10を薬液循環槽20に戻入する。また、薬液循環槽2 0は開閉弁26を介しドレイン側に連結し、三方開閉弁 24も排出管27によりドレイン側に連結される。以上 の構造により適温に加温された薬液10がポンプ18等 を介して薬液循環槽20から弧状箱体9内に供給され、 円弧状の流路1を流通して再び薬液循環槽20内に戻入 されて循環する。

【0018】次に、吸着手段3を説明する。図4に示すように円盤状の吸着盤8は弧状箱体9の流路1内に収納されて配置され、その表面側にはウェーハ2が搭載される。吸着盤8には回転軸11が連結すると共に、回転軸11の内部に貫通形成された空気孔(図略)は吸着盤8内に貫通形成される多数個の吸引孔28に連通する。一方、回転軸11内の前記空気孔は開閉弁29を介して真空タンク30に管路31により連結し、真空タンク30には真空ポンプ32が連結して真空タンク30内を真空による。以上の構造に開閉弁29を開放することによりウェーハ2は吸着盤8の表面に真空吸着保持される。

【0019】次に、回転手段4を説明する。回転軸11は図4に示すように弧状箱体9の支持部9cにシール手段33によりシールされて支持される。回転軸11側に設けられたプーリ(図略)にはプーリ用ベルト34を介し駆動モータ35側のブーリ36が連結される。また、回転軸11と真空タンク30間には回転軸11まわりから洩れた薬液10を回収するためのドレンパネル37が介設され管路38を介してドレイン側に連通する。以上の構造により駆動モータ35を作動することにより吸着盤8に吸着されたウェーハ2が流路1内で自転する。

【0020】次に、テンプレート5について説明する。 図2、図4および図9に示すように、吸着盤8の外周に はリング状のテンプレート5が固着される。テンプレー ト5の内壁側と吸着盤8上に吸着保持されたウェーハ2 の外縁との間には間隙δが形成される。間隙δの値は実 験的、経験的に設定される。また、テンプレート5の上 面とウェーハ2のエッチング処理される表面(上面)と はほぼ同一平面上に形成される。

【0021】次に、本実施例の作用を説明する。ウェー ハ2は前記したように流路1内のほぼ中間部に配置され る。真空ポンプ32を作動し、吸着盤8にウェーハ2を 吸着保持する。ポンプ18を作動し、薬液循環槽20内 の薬液10を供給側の分配器14側に送る。薬液10等 は分散板12により弧状箱体9内に流入し、図1に示し たような円弧状の薬液10の流れを流路1内に形成す る。流路1を通過した薬液10は排出側の分散板13お よび分配器15を介して集約され薬液循環槽20内に戻 入される。一方、駆動モータ35を作動することにより ウェーハ2が自転する。図3に示すようにウェーハ2が 矢印G方向(薬液の流れ方向を示す矢印Hと同一回転方 向) に自転し、流路1内を矢印Hのように薬液10が流 れ、両者の速度を適宜コントロールすることによりウェ -ハ2面の各部位に対する薬液10の相対平均流速をほ ほ均一にすることができる。相対平均流速が均一になる とウェーハ2の表面のエッチング代のバラツキが減少 し、その結果、平坦性のあるエッチドウェーハが形成さ れる。一方、ウェーハ2の外縁近傍には前記した形状の テンプレート5が配置されるため図9に示すように矢印 Bからの薬液10の流れがテンプレート5により整流さ れ、ウェーハ2の外縁での流速の乱れが減少し、外縁の 形状変化が緩和される。図10はその状態を示すもの で、図12の場合に較べてエッジ部における形状の異常 が大幅に改善されることがわかる。

【0022】実施例2

本実施例はウェーハ2側を自転及び公転させて薬液10 とウェーハ2面の各部位に対する薬液の相対平均流速を 極力均一に保持するようにしたエッチング装置を示す。 図5に示すように、薬液10は円環状(ドーナツ状)の 薬液槽7内に蓄溜され、ウェーハ2は矢印」了方向に自転 すると共に矢印K方向に公転すべく形成される(矢印J 方向と矢印 K方向は互いに反対回転方向である)。図6 に示すようにウェーハ2は吸着手段3 a の吸着盤8 a の 図の下面側に吸着支持される。また、ウェーハ2の外縁 側には図2に示したと同様にテンプレート5aが配設さ れる。図8は図5をより詳細に示したもので、公転手段 6の先端側に配設された吸着手段3aおよび回転手段4 a (後記) によりウェーハ2は保持される。なお、図8 に示すように吸着手段3aは図4に示した吸着手段3と 同様に形成され、同一符号のものは同一物又は同一機能 の物を示しその説明を省略する。なお、この場合、吸着 手段3aはウェーハ2と共に公転するため後記する公転 手段6側に設置される(詳細構造省略)。なお、図6に おいて矢印Kはウェーハ2の回転方向を示し、矢印Mは 真空吸着方向を示す。

【0023】次に、ウェーハ2の公転および自転手段と 薬液槽7への薬液10の供給、排出系路構造を図7によ り説明する。公転手段6は薬液槽7の中心位置において 7

装置の不動側に枢支される中心軸39と、中心軸39を 回転させる公転用駆動モータ40と、中心軸39に基端 側を連結すると共に先端側に吸着手段3a および回転手 段4 a を装着するアーム部材41等からなる。一方、回 転手段4aは、アーム部材41に固定される駆動モータ 42からなり、駆動モータ42は吸着盤8aに連結する 回転軸11に連結される。薬液循環槽20a内の薬液1 0は配管43および開閉弁44を介して薬液槽7内に供 給される。また、薬液槽7内の薬液10は三方開閉弁4 5を介して薬液循環槽20a及びドレイン側に戻入され 10 る。また、薬液循環槽20a内の薬液10は温調器23 aにより適温に加温される。なお、薬液循環槽20aに は開閉弁46を介してドレイン側に連結される。以上の 構造により、公転手段6のアーム部材41の先端側に配 置された吸着手段3aに吸着保持されたウェーハ2は、 回転手段4 aにより自転されると共に公転用駆動モータ 40を作動することによりアーム部材41を介して公転 される。

【0024】次に、本実施例の作用について説明する。 吸着手段3 a により吸着保持されたウェーハ2は薬液槽 20 7内の薬液10に浸漬され下向きに配置される。ウェーハ2の自転と公転により、ウェーハ2と薬液10との間には流れが生ずるがウェーハの自転と公転の回転速度と方向を適宜設定することによりウェーハ2と薬液10間の相対平均流速をほぼ均一に保持することが可能となり、前記実施例1とほぼ同様なエッチング効果を上げることができる。勿論、テンプレート5 a により、ウェーハ2のエッジ部の形状変化も緩和される。

【0025】以上の実施例において、図示のような吸着手段3、3 a、回転手段4、4 a および公転手段6等を 30 採用したが、その詳細構造は図示のものに限定するものではない。また、実施例1の流路1を1/4弧状のものとしたがそれに限定するものではない。また、流路1 および薬液槽7に係合するウェーハ2を単一のものとしたが、それに限定するものではない。更に、薬液槽7は単純なドーナツ状のものとしたが、同心円状の多層のものでもよい。

[0026]

【発明の効果】本発明によれば、次のような顕著な効果 を奏する。

- (1) 薬液を弧状の流路内に流通させその流路内でウェーハを自転する装置構造を採用し、また、薬液を蓄溜する円環状の薬液槽内でウェーハを自転及び公転させる装置構造を採用することにより、ウェーハ面の各部位と薬液間の相対平均流速をほぼ均一にすることができる。それにより、ウェーハの平坦度の精度向上が図れる。
- (2)相対平均流速中でシリコンウェーハを自転するととによりエッチング時に生ずる反応ガスによる凹凸が低減し平滑なエッチング処理が行われ、高精度の平坦度が得られる。

(3) ウェーハの外縁に近接させてテンプレートを設けることにより、ウェーハの外縁まわりの薬液の流れが整流され、エッジの形状変化が緩和され、高精度のケミカルエッチドウェーハを形成することができる。

(4)装置構造がコンパクトにまとめられ、かつ特別の 機器を使用しない簡便なものから構成されるため、比較 的安価な設備費により実施が可能である。

【図面の簡単な説明】

【図1】本実施例の第1の実施例を説明するための平面 図である。

【図2】第1の実施例のウェーハ吸着手段およびテンプレートとの係合状態を示す軸断面図である。

【図3】第1の実施例の流路および流路への薬液の供給 排出系路構造を示す構成図である。

【図4】第1の実施例の吸着手段とウェーハの回転手段 を示す構成図である。

【図5】本発明の第2の実施例を説明するための平面図である。

【図6】第2の実施例のウェーハ吸着手段およびテンプ ・レートとの係合状態を示す軸断面図である。

【図7】第2の実施例のウェーハの自公転手段と薬液槽への薬液の供給排出系路構造を示す構成図である。

【図8】第2の実施例の薬液槽と吸着手段の概要構造を 示す平面図である。

【図9】第1 および第2の実施例におけるテンプレートの効果を説明するための説明用平面図である。

【図10】テンプレートの効果を示す線図である。

【図11】従来のウェーハの問題点を説明するための説 明用平面図である。

【図12】従来のエッチング装置におけるウェーハのエッジ部の形状変化を示す線図である。

【符号の説明】

- 1 流路
- 2 半導体結晶ウェーハ (ウェーハ)
- 3, 3 a 吸着手段
- 4. 4a 回転手段
- 5, 5a テンプレート
- 6 公転手段
- 7 薬液槽
- 0 8,8a 吸着盤
 - 9 弧状箱体
 - 9 a 枠体部
 - 9 b 開閉蓋
 - 9 c 支持部
 - 10 薬液
 - 11 回転軸
 - 12,13 分散板
 - 14,15 分配器
 - 16 流量計
- 50 17, 22, 26, 29, 44, 46 開閉弁

18 ポンプ

19, 21, 31, 38 管路

20 藁液循環器

20a 薬液循環槽

23, 23a 温調器

24 三方開閉弁

25 戻入管

27 排出管

28 吸引孔

30 真空タンク

32 真空ポンプ

*33 シール手段

34 プーリ用ベルト

35,42 駆動モータ

36 プーリ

37 ドレンパネル

39 中心軸

40 公転用駆動モータ

41 アーム部材

43 配管

10 45 三方開閉弁

*

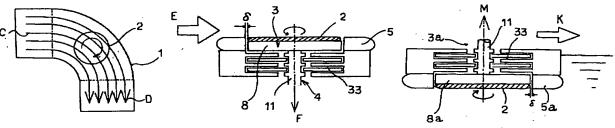
[図2]

(図1)

3

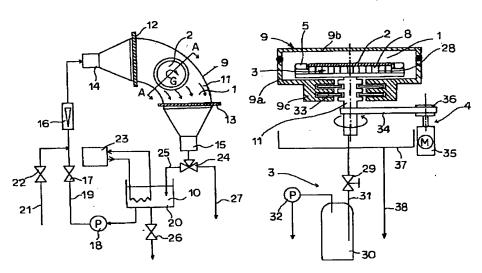
[図6]

10

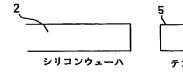


【図3】

【図4】

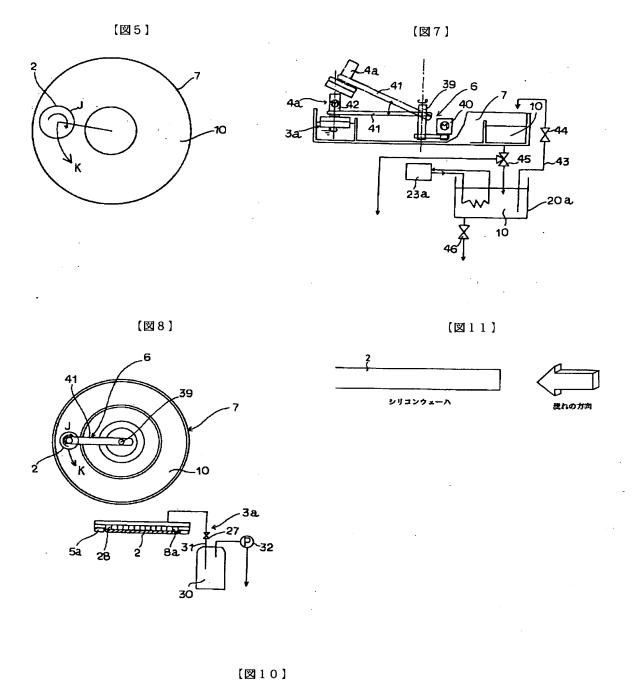


【図9】









厚さ ウェーハ半径方向の距離

[図12]

